

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.2 «Патентоведение»

по направлению подготовки: 18.03.01 «Химическая технология»
по профилю «Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»

Квалификация выпускника: БАКАЛАВР

Выпускающая кафедра: ТНВМ

Кафедра-разработчик рабочей программы: методологии инженерной деятельности

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Патентоведение» являются:

- а) формирование знаний о правовых основах охраны объектов патентного права, критериях их патентоспособности и оформлении патентных прав;
- б) обучение технологии классифицирования, выявления объектов патентного права, способам поиска, отбора, анализа и обработки патентной информации;
- в) раскрытие сущности патентных исследований.

2. Содержание дисциплины «Патентоведение»

Патентное право и его основные понятия.

Субъекты и объекты патентного права.

Выявление изобретений.

Оформление патентных прав.

Международная патентная классификация изобретений.

Классифицирование изобретений в системе Международной патентной классификации.

Патентная информация и ее поиск.

Практическая работа по поиску патентной информации.

Патентных исследования.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:

- а) особенности правовой защиты объектов патентного права;
- б) перечень объектов патентного права и критерии их патентоспособности;
- в) содержание государственной экспертизы объектов патентного права;
- г) назначение и структуру Международной патентной классификации изобретений.

2) Уметь:

- а) оперировать понятиями и определениями патентного права;
- б) классифицировать изобретения в системе Международной патентной классификации;
- в) осуществлять поиск патентной информации, ее чтение и анализ.

3) Владеть:

- а) способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;

б) способностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях.

Зав. кафедрой ТНВМ



Хацринов А.И.